

(11)Publication number:

10-307388

(43)Date of publication of application: 17.11.1998

(51)Int.CI.

G03F 7/022 C08F 2/46 G03F 7/004 G03F 7/033 G03F 7/039 H01L 21/027 H01L 21/768

(21)Application number: 09-115846

(71)Applicant: JSR CORP

(22)Date of filing:

06.05.1997

(72)Inventor: OGASAWARA SHOJI

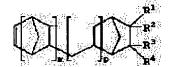
SUZUKI MASAMUTSU NISHIMURA ISAO ENDO MASAYUKI

(54) RADIATION SENSITIVE RESIN COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the radiation sensitive resin composition superior in various performances, such as electric nonconductance, flatness, heat resistance, transparence, and resistance to chemicals, and capable of easily forming a patternwise thin film low in dielectric constant by incorporating a 1,2-quinonediazido compound and a cross-linking agent capable of reacting with a specified resin and forming bridges between each resin molecule.

SOLUTION: This radiation sensitive resin composition contains (A) an alkali— soluble cyclic polyolefin resin, (B) the 1,2quinonediazido compound, and (C) the cross—linking agent having a functional group capable of forming bridges between each molecule of the resin (A). The resin (A) can be embodied by the hydrolyzate of the ring—opening polymer or copolymer or the like made from a monomer represented by the formula in which each of R1 and R3 is, independently, an H atom or a hydrocarbon group or a polar group except a hydrocarbon group; and each of (m) and (p) is an integer of 0–3.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

01.10.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against miner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-307388

(43)公開日 平成10年(1998)11月17日

(51)Int.Cl. ⁶		識別記号		FΙ			•		
G03F	7/022			G 0	3 F	7/022			
C08F	2/46			C 0	8 F	2/46			
G03F	7/004	503		G 0	3 F	7/004		503Z	
	7/033					7/033			
	7/039	501				7/039		501	
			審查請求	未請求	散 求簡	項の数 1	OL	(全 15 頁)	最終頁に続く
 (21)出願番号	•	特願平9-115846		(71)	出願丿	000004	178		
						ジェイ	エスア	ール株式会社	
(22) 出願日		平成9年(1997)5月6日				東京都	中央区	築地2丁目11	番24号
				(72) 発明者	1 小笠原	昭二			
						東京都	中央区	築地二丁目11	番24号 日本合
						成ゴム	株式会	社内	
				(72)	発明者	針 鈴木	正睦		
						東京都	中央区	築地二丁目11	番24号 日本合
						成ゴム	株式会	社内	
				(72)	発明者	香 西村	功		
						東京都	中央区	築地二丁目11	番24号 日本合
						成ゴム	株式会	社内	
				(74)	代理人	ト 弁理士	大島	正孝	
				最終頁に続く					

(54) 【発明の名称】 感放射線性樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 絶縁性、平坦性、耐熱性、透明性、耐薬品性 などの諸性能に優れるとともに、低誘電性に優れたパタ ーン状薄膜を容易に形成することができる感放射線性樹 脂組成物を提供すること。

【解決手段】 [A] アルカリ可溶性環状ポリオレフィ ン系樹脂、 [B] 1,2-キノンジアジド化合物および [C] 樹脂 [A] と反応して樹脂 [A] 間に架橋を形成 しうる官能基を有する架橋剤を含有する感放射線性樹脂 組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 [A] アルカリ可溶性環状ポリオレフィ ン系樹脂、[B] 1,2-キノンジアジド化合物 およ び [C] 樹脂 [A] と反応して樹脂 [A] 間に架橋を形 成しうる官能基を有する架橋剤を含有することを特徴と する感放射線性樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感放射線性樹脂組 成物に関する。さらに詳しくは、電子部品に用いられる 10 保護膜などを形成するための材料、または層間絶縁膜、 特に、液晶表示素子、集積回路素子、固体撮像素子など の層間絶縁膜を形成するための材料として好適な低誘電 性の感放射線性樹脂組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、液晶表示素子、集積回路素子、 固体撮像素子などの電子部品には、その劣化や損傷を防 止するための保護膜、素子表面を平坦化するための平坦 化膜、電気絶縁性を保つための絶縁膜などが設けられて いる。また、薄膜トランジスタ(以下、「TFT」と記 20 す。)型液晶表示素子や集積回路素子には、層状に配置 される配線の間を絶縁するために層間絶縁膜が設けられ

【0003】しかし、従来知られている電子部品用の熱 硬化型絶縁膜形成用の材料を用いて例えば層間絶縁膜を 形成する場合には、必要とするパターン形状の層間絶縁 膜を得るための工程数が多くしかも十分な平坦性を有す る層間絶縁膜が得られないという問題があるため、パタ ーニング可能な感光性絶縁膜形成材料の開発が求められ てきた。また、近年、配線やデバイスの高密度化にとも 30 ない、これらの材料に低誘電性が求められるようになっ てきた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、以上のよう な事情に基づいてなされたものであって、その目的は、 絶縁性、平坦性、耐熱性、透明性、耐薬品性などの諸性 能に優れるとともに、低誘電性に優れたパターン状薄膜 を容易に形成することができる感放射線性樹脂組成物を 提供することにある。本発明の他の目的は、感光性、感 光後のアルカリ水溶液による現像性、得られる膜の耐熱 40 性、耐溶剤性および透明性を良好に維持しつつ、得られ る膜の低誘電化を図るという困難な問題を克服して、上 記の如き本発明の感放射線性樹脂組成物を提供すること にある。本発明のさらに他の目的および利点は、以下の 説明から明らかになろう。

[0005]

【発明を解決するための手段】本発明によれば、本発明 の上記目的および利点は、[A] アルカリ可溶性環状ポ リオレフィン系樹脂、[B] 1,2-キノンジアジド化

架橋を形成しうる官能基を有する架橋剤を含有すること を特徴とする感放射線性樹脂組成物によって達成され

【0006】以下、まず本発明に係る感放射線性樹脂組 成物に含まれる各成分について説明する。なお、本発明 で「放射線」という語は、紫外線、遠紫外線、X線、電 子線、分子線、γ線、シンクロトロン放射線、プロトン ビーム線などを含む概念で用いられる。

【0007】本発明に用いられるアルカリ可溶性環状ポ リオレフィン系樹脂としては、次のような重合体の加水 分解物を挙げることができる。

①下記式(1)で表される単量体(以下、特定単量体と いう)の開環(共)重合体、

②特定単量体と共重合性単量体との開環共重合体、

③前記開環(共)重合体の水素添加重合体、

<特定単量体>

[0008]

【化1】

【0009】式中、R¹およびR³は、互いに独立に水素 原子または炭化水素基であり、R2およびR4は、互いに 独立に水素原子、炭化水素基または炭化水素基以外の極 性基であり、mは0~3の整数であり、そしてpは0~ 3の整数である。但し、R2およびR4の少なくとも1つ は炭化水素以外の極性基である。

【0010】上記式(1)で表される特定単量体のう ち、好ましいのは、式中、R¹およびR³は、互いに独立 に水素原子または炭素数1~10の炭化水素基であり、 R²およびR⁴の少なくとも一つは炭化水素基以外の極性 基であり、mは0~3の整数であり、そしてpは0~3 の整数であるものである。好ましくはm+pが0~4、 特に好ましくは0~2、就中、1のものである。特定単 量体のうち、極性基が特に式-(CH2) nCOORで表 される特定の極性基である特定単量体は、得られる感放 射線性樹脂組成物の感度が特に良好となり好ましい。上 記の特定の極性基を示す式において、Rは炭素数1~1 2の炭化水素基、好ましくはアルキル基である。また、 nは通常、0~5である。

【0011】上記式(1)で表わされる特定単量体の具 体例としては、次のような化合物が挙げられる。5-ア セトキシビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ー メトキシカルボニルビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ー エン、5-メチル-5-メトキシカルボニルビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ーシアノビシクロ $[2, 2, 1] \land \forall l - 2 - x \lor (8 - r t + r t) > r + r t$ シクロ $[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]$ -3 - ドデセン、8 合物および [C] 樹脂 [A] と反応して樹脂 [A] 間に 50 ーメトキシカルボニルテトラシクロ [4.4.0.1^{2.5}.

3 17.10] -3-ドデセン、8-エトキシカルボニルテト ラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]$ -3 - ドデセン、 8-n-プロポキシカルボニルテトラシクロ[4.4. $0.1^{2.5}.1^{7.10}$] -3-i \vec{r} \vec{r} シカルボニルテトラシクロ [4.4.0.12.5.17.10] -3-ドデセン、8-n-ブトキシカルボニルテトラシ クロ [4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] -3-ドデセン、8-メチルー8-メトキシカルボニルテトラシクロ[4.4. エトキシカルボニルテトラシクロ [4, 4, 0, 1^{2, 5}, 1 [7,10] - 3 - ドデセン、8 - メチル - 8 - n - プロポキ シカルボニルテトラシクロ $[4, 4, 0, 1^{2,5}, 1^{7,10}]$ -3-ドデセン、8-メチル-8-イソプロポキシカル ボニルテトラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]$ -3-ドデセン、8-メチル-8-n-プトキシカルボニルテ トラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]$ -3 - ドデセ ン、8-(2,2,2-トリフルオロエトキシカルボニ ル) テトラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]$ -3 -ド デセン、8-メチル-8-(2,2,2-トリフルオロエ トキシカルボニル) テトラシクロ [4.4.0.12.5.1] 7.10] -3-ドデセン。これらのうち、感度、誘電率の バランスが良い感放射線性樹脂組成物を与える8-メチ ルー8-メトキシカルボニルテトラシクロ「4.4.0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$] -3 ードデセンが特に好ましい。 【0012】<共重合性単量体>アルカリ可溶性環状ポ リオレフィン系樹脂としては、上記の特定単量体を単独 で開環重合させた単独重合体でもよいが、当該特定単量

体と共重合性単量体とを開環共重合させた共重合体でも よい。この場合に使用される共重合性単量体としては、 未置換のシクロオレフィンあるいは炭化水素基、ハロゲ 30 ン化炭化水素基またはハロゲン原子で置換されたシクロ オレフィンが好ましく用いられる。これらのうち、シク ロオレフィン部分の炭素数が4~20のものが好まし く、5~21のものがより好ましい。また、シクロオレ フィン部分はモノー、ビー、トリー、テトラー、ペンタ - またはヘキサーシクロ体であるものが好ましい。 【0013】かかる共重合性単量体の具体例としては、 ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、トリシクロ $[5.2.1.0^{2.6}] - 8 - \vec{r}$ \vec{r} \vec{r} 4.0.1 $^{2.5}$.1 $^{7.10}$] -3 - ドデセン、ペンタシクロ $[6.5.1.1^{3.6}.0^{2.7}.0^{9.13}] - 4 - \% y$ ン、ペンタシクロ $[7.4.0.1^{2.5}.1^{9.12}.0^{8.13}]$ -3 - ペンタデセン、トリシクロ [4.4.0.1^{2.5}] - 3ーウンデセン、5ーメチルビシクロ[2.2.1] ヘプト -2-エン、5-エチルビシクロ[2.2.1] ヘプトー 2-エン、ジメタノオクタヒドロナフタレン、エチルテ トラシクロドデセン、6-エチリデン-2-テトラシク ロドデセン、トリメタノオクタヒドロナフタレン、ペン タシクロ [8.4.0.12.5.19.12.08.13] - 3 - ヘキ サデセン、ヘプタシクロ [8.7.0.13.6.110.17.1

12.15.02.7.011.16] -4-エイコセン、ヘプタシクロ[8.8.0.14.7.111.18.113.16.03.8.012.17] -5-ヘンエイコセン、

【0014】5-エチリデンビシクロ[2.2.1] ヘプ トー2-エン、8-エチリデンテトラシクロ[4.4. $0.1^{2.5}.1^{7.10}$] -3-ドデセン、5-フェニルビシ クロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、8ーフェニルテト ラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]$ -3 - ドデセン、 5-フルオロビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、 5-フルオロメチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-トリフルオロメチルビシクロ[2.2.1]へ プトー2ーエン、5ーペンタフルオロエチルビシクロ シクロ [2.2.1] ヘプト-2-エン、5,6-ジフル オロビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエン、5.5ー ビス (トリフルオロメチル) ビシクロ [2.2.1] ヘプ トー2-エン、5,6-ビス(トリフルオロメチル)ビ シクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-メチル-5 ートリフルオロメチルビシクロ[2.2.1] ヘプトー2 -エン、5, 5, 6 -トリフルオロビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエン、5,5,6ートリス(フルオロメチ ル) ビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-エン、5,5, 6,6-テトラフルオロビシクロ[2.2.1] ヘプトー 2-エン、5,5,6,6-テトラキス(トリフルオロメ チル) ビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-エン、5,5 -ジフルオロー6,6-ビス(トリフルオロメチル)ビ シクロ [2.2.1] ヘプト-2-エン、5,6-ジフル オロー5,6ービス(トリフルオロメチル)ビシクロ ロー5ートリフルオロメチルビシクロ[2.2.1] ヘプ トー2-エン、5-フルオロー5-ペンタフルオロエチ ルー6,6ービス(トリフルオロメチル)ビシクロ[2. 2.1] $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ プタフルオローisoープロピルー6ートリフルオロメ チルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-クロ ロー5, 6, 6ートリフルオロビシクロ[2.2.1] ヘプ トー2ーエン、5,6ージクロロー5,6ービス(トリフ ルオロメチル) ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエ ン、5,5,6ートリフルオロー6ートリフルオロメトキ 40 シビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエン、5,5,6ー トリフルオロー6-ヘプタフルオロプロポキシビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエン、 【0015】8-フルオロテトラシクロ[4.4.0.1

 $2.5.1^{7.10}$] -3-F \overrightarrow{r} \overline{t} \overline{t}

ラシクロ $[4, 4, 0, 1^{2.5}, 1^{7.10}]$ -3 - ドデセン、 8, 9-ジフルオロテトラシクロ [4.4.0.1^{2.5}.1 7.10] -3ードデセン、8,8ービス(トリフルオロメ チル) テトラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]$ - 3 -ドデセン、8,9-ビス(トリフルオロメチル)テトラ シクロ $[4, 4, 0, 1^{2,5}, 1^{7,10}]$ -3 - ドデセン、8 -メチル-8-トリフルオロメチルテトラシクロ「4. 4.0.1 $^{2.5}$.1 $^{7.10}$] -3 -ドデセン、8,8,9ートリ フルオロテトラシクロ $[4, 4, 0, 1^{2.5}, 1^{7.10}]$ - 3 ードデセン、8,8,9-トリス(トリフルオロメチル) テトラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]$ -3 - ドデセ ン、8,8,9,9ーテトラフルオロテトラシクロ[4. テトラキス (トリフルオロメチル) テトラシクロ [4. オロー9,9ービス(トリフルオロメチル)テトラシク ロ [4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] -3ードデセン、8,9ー ジフルオロー8,9ービス(トリフルオロメチル)テト ラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]$ -3 - ドデセン、 8,8,9-トリフルオロー9-トリフルオロメチルテト ラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]$ -3 - ドデセン、 8,8,9-トリフルオロー9-トリフルオロメトキシテ トラシクロ $[4, 4, 0, 1^{2.5}, 1^{7.10}]$ -3 - ドデセ ン、8,8,9ートリフルオロー9ーペンタフルオロプロ ポキシテトラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]$ -3 -ドデセン、8-フルオロ-8-ペンタフルオロエチルー 9,9-ビス (トリフルオロメチル) テトラシクロ [4. オロー8-ヘプタフルオロisoープロピルー9ートリ フルオロメチルテトラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}]$ $1^{7.10}$] -3ードデセン、8ークロロー8, 9, 9ートリ フルオロテトラシクロ $[4, 4, 0, 1^{2, 5}, 1^{7, 10}]$ - 3 ードデセン、8,9ージクロロー8,9ービス(トリフル オロメチル) テトラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]$ -3-ドデセン、シクロペンテン、シクロヘプテン、シ クロオクテン、トリシクロ [5.2.1.0^{2.6}] - 3 ーデ セン、5-エチリデン-2-ノルボルネン、ジシクロペ ンタジエンなどを挙げることができる。

【0016】さらにポリブタジエン、ポリイソプレン、 スチレンーブタジエン共重合体、エチレンー非共役ジエ 40 ン共重合体、ポリノルボルネンなどの主鎖に炭素ー炭素 間二重結合を含む不飽和炭化水素系ポリマーなども、こ こに云う共重合性単量体として使用することができる。 この場合、共重合体は、かかるポリマーの存在下に特定 単量体を開環重合させることにより製造される。

【0017】 (不飽和二重結合含有化合物) 飽和共重合 体である環状オレフィン系重合体を得るために、前記特 定単量体と共に使用される不飽和二重結合含有化合物と しては、炭素数2~12、好ましくは2~8のオレフィ ばエチレン、プロピレンおよびブテンを挙げることがで きる。

【0018】<重合触媒>本発明において、アルカリ可 溶性環状ポリオレフィン化合物である上記開環(共)重 合体①および開環共重合体②を製造する際の開環重合反 応はメタセシス触媒の存在下に行われる。このメタセシ ス触媒は、(a) W、MoおよびReの化合物から選ば れた少なくとも1種と、(b) デミングの周期律表 I A 族元素(例えばLi、Na、Kなど)、IIA族元素(例 えばMg、Caなど)、IIB族元素(例えばZn、C d、Hgなど)、IIIA族元素(例えばB、Alな ど)、IVA族元素(例えばSi、Sn、Pbなど)ある いはIVB族元素(例えばTi、Zrなど)を含有し且つ 少なくとも1つの当該元素-炭素結合および/または当 該元素-水素結合を有する化合物との組合せからなる触 媒である。またこの場合に触媒の活性を高めるために、 後述の添加剤(c)を含有するものであってもよい。 (a) 成分として適当なW、MoあるいはReの化合物 の代表例としては、WC16、MoC15、ReOC1 3 など特開平1-240517号公報に記載の化合物を 挙げることができる。(b)成分の具体例としては、n -C4H9Li, (C2H5) 3Al, (C2H5) 2AlC 1, (C2H5) 1.5 A 1 C 11.5, (C2H5) A 1 C l2、メチルアルモキサン、LiHなど特開平1-24 0517号公報に記載の化合物を挙げることができる。 添加剤である(c)成分の代表例としては、アルコール 類、アルデヒド類、ケトン類、アミン類などを好適なも

【0019】メタセシス触媒の使用量は、上記(a)成 分と単量体とのモル比で「(a)成分:単量体」が、通 常1:500~1:50,000となる範囲、好ましく は1:1,000~1:40,000となる範囲とされ る。(a)成分と(b)成分との割合は、金属原子比で (a) 成分: (b) 成分が1:1~1:50、好ましく は1:2~1:30の範囲とされる。(a)成分と (c) 成分との割合は、モル比で(c) 成分: (a) 成 分が0.005:1~15:1、好ましくは0.05:1 ~7:1の範囲とされる。

のとして挙げることができるが、更に特開平1-240

517号公報に示される化合物を使用することもでき

【0020】<開環重合反応用溶媒>上記開環重合反応 において用いられる溶媒(分子量調節剤溶液を構成する 溶媒、単量体および/またはメタセシス触媒の溶媒)と しては、例えばペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタ ン、ノナン、デカンなどのアルカン類;シクロヘキサ ン、シクロヘプタン、シクロオクタン、デカリン、ノル ボルナンなどのシクロアルカン類;ベンゼン、トルエ ン、キシレン、エチルベンゼン、クメンなどの芳香族炭 化水素;クロロブタン、プロムヘキサン、塩化メチレ ン系化合物が用いられる。かかる化合物としては、例え 50 ン、ジクロロエタン、ヘキサメチレンジブロミド、クロ

る。

ロベンゼン、クロロホルム、テトラクロロエチレンなどのハロゲン化アルカンまたはハロゲン化アリール化合物:酢酸エチル、酢酸nーブチル、酢酸isoーブチル、プロピオン酸メチル、ジメトキシエタンなどの飽和カルボン酸エステル類;およびジブチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタンなどのエーテル類などを挙げることができ、これらは単独であるいは混合して用いることができる。これらのうち、芳香族炭化水素が好ましい。溶媒の使用量としては、「溶媒:単量体(重量比)」が、通常1:1~10:1となる量とされ、好ましくは1:1~5:1となる量とされる。

【0021】<分子量調節剤>開環重合体①および②の分子量の調節は、重合温度、触媒の種類、溶媒の種類によっても行うことができるが、本発明においては、分子量調節剤を反応系に共存させることにより調節するのが特に好ましい。好適な分子量調節剤としては、例えばエチレン、プロペン、1ーブテン、1ーペンテン、1ーペンテン、1ーペンテン、1ーデセンなどのαーオレフィン類およびスチレンを挙げることができる。これらのうち、1ーブテン、1ーペキセンが特に好ましい。これらの分子量調節剤は、単独であるいは2種以上を混合して用いることができる。分子量調節剤の使用量としては、開環重合反応に供される単量体1モルに対して好ましくは0.005~5.0モル、より好ましくは0.02~2.5モルとされる。

【0022】本発明で用いられる環状オレフィン系重合体の分子量はゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)で測定したポリスチレン換算の数平均分子量(Mn)は2,000~30,000、重量平均分子量(Mw)(以下、単に数平均分子量、重量平均分子量という)は5,000~100,000の範囲のものが好適である

【0023】<水素添加触媒>以上のようにして得られた開環重合体は、水素添加触媒を用いて水素添加でき、上記水素添加重合体③を与える。水素添加反応は、通常の方法、すなわち、開環重合体①、②の溶液に水素添加触媒を添加し、これに常圧~300気圧、好ましくは3~200気圧の水素ガスを0~200℃、好ましくは20~180℃で作用させることによって行われる。水素添加触媒としては、通常のオレフィン性化合物の水素添加反応に用いられるものを使用することができる。この水素添加触媒としては、不均一系触媒および均一系触媒が公知である。

【0024】不均一系触媒としては、例えばパラジウ ル、3-エトキシプロピオン酸エチル、3-エトキシ ロピオン酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチルなどのエ 属触媒物質を、例えばカーボン、シリカ、アルミナ、チ タニアなどの担体に担持させた固体触媒を例として挙げ リドンなどの非プロトン性極性溶媒が挙げられる。 N ることができる。また、均一系触媒としては、例えばナ フテン酸ニッケル/トリエチルアルミニウム、ニッケル アセチルアセトナート/トリエチルアルミニウム、オク 50 N, Nージメチルアセトアミド、Nーメチルピロリド

テン酸コバルト/nーブチルリチウム、チタノセンジクロリド/ジエチルアルミニウムモノクロリド、酢酸ロジウム、クロロトリス(トリフェニルホスフィン)ロジウム、ジクロロトリス(トリフェニルホスフィン)ルテニウム、クロロヒドロカルボニルトリス(トリフェニルホスフィン)ルテニウム、ジクロロカルボニルトリス(トリフェニルホスフィン)ルテニウムなどを挙げることができる。これらの触媒の形態は粉末でも粒状でもよい。

【0025】これらの水素添加触媒は、開環重合体:水素添加触媒の(重量比)が、 $1:1\times10^{-6}\sim1:2$ となる割合で使用される。このように、水素添加することにより得られる水素添加重合体3は優れた熱安定性を有するものとなり、製品としての使用時の加熱によってはその特性が劣化することはない。ここに、水素添加率は、通常50%以上、好ましく70%以上、更に好ましくは90%以上である。

【0026】 <加水分解>上記①~③の如き(共)重合体を加水分解することにより、アルカリ可溶性の環状ポリオレフィン系樹脂を得ることができる。加水分解の方法には特に制限はなく、通常のアルカリおよび酸加水分解が使用できる。

【0027】反応溶剤としては、例えばメタノール、エタノール、プロパノール、ブタノールなどのアルコール類;テトラヒドロフラン、ジオキサンなどの環状エーテル類;メチルセロソルブアセテート、エチルセロソルブアセテートなどのセロソルブエステル類;エチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールメチルエーテルなどのグリコールエーテル類;プロピレングリコールメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールプロピルエーテルアセテートなどのプロピレングリコールアルキルエーテルアセテート類;

【0028】ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香 族炭化水素類;メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、2ーヘプタノン、4ーヒドロキシー4ーメチルー2ーペンタノンなどのケトン類;2ーヒドロキシプロピオン酸エチル、2ーヒドロキシー2ーメチルプロピオン酸エチル、2ーヒドロキシー2ーメチルプロピオン酸エチル、エトキシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、2ーヒドロキシー3ーメチルブタン酸メチル、3ーメトキシプロピオン酸メチル、3ーエトキシプロピオン酸エチル、3ーエトキシプロピオン酸エチル、3ーエトキシプロピオン酸エチル、1ーピオン酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチルなどのエステル類;ジメチルホルムアミド、Nーメチルカアミド、Nーメチルホルムアミド、Nーメチルホルムアミド、Nーメチルアセトアミド、Nーメチルピロリド

ン、ジメチルスルホキシド、ベンジルエチルエーテル、ジヘキシルエーテル、アセトニルアセトン、イソホロン、カプロン酸、カプリル酸、1ーオクタノール、1ーノナノール、ベンジルアルコール、酢酸ベンジル、安息香酸エチル、シュウ酸ジエチル、マレイン酸ジエチル、ッーブチロラクトン、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、フェニルセロソルブアセテート、水などの溶媒を単独あるいは混合して用いることができる。重合体の加水分解率は、反応温度、反応時間、酸、アルカリ量を調整することで任意に変更することができる。

【0029】 [B] 1,2ーキノンジアジド化合物本発明で用いられる1,2ーキノンジアジド化合物としては、ヒドロキシ化合物と1,2ーキノンジアジドスルホン酸とのエステル化物が用いられる。この1,2ーキノンジアジド化合物としては、ヒドロキシ化合物の水酸基の全てまたは一部が1,2ーキノンジアジドスルホン酸でエステル化された化合物を用いることができ、具体的にヒドロキシ化合物の水酸基の20~100%が1,2ーキノンジアジドスルホン酸でエステル化された化合物を用いることができる。

【0030】このような1,2ーキノンジアジド化合物の具体例としては、2,3,4ートリヒドロキシベンソフェノン-1,2ーナフトキノンジアジド-4ースルホン酸エステル、2,3,4ートリヒドロキシベンゾフェノン-1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステル、2,4,6ートリヒドロキシベンゾフェノン-1,2ーナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、2,4,6ートリヒドロキシベンゾフェノン-1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステルなどの、トリヒドロキシベンゾフェノンと1,2ーキノンジアジドスルホン酸とのエステル化物;

【0031】2,2',4,4'ーテトラヒドロキシベン ゾフェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー4ースル ホン酸エステル、2,2',4,4'ーテトラヒドロキシ ベンゾフェノンー1,2-ナフトキノンジアジドー5-スルホン酸エステル、2,3,4,3'ーテトラヒドロキ シベンゾフェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー4 ースルホン酸エステル、2,3,4,3'ーテトラヒドロ キシベンゾフェノンー1,2-ナフトキノンジアジドー 5-スルホン酸エステル、2,3,4,4'ーテトラヒド ロキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジド -4-スルホン酸エステル、2,3,4,4'ーテトラヒ ドロキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジ ドー5ースルホン酸エステル、2,3,4,2'ーテトラ ヒドロキシー4'ーメチルベンゾフェノンー1,2ーナ フトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、2,3, 4,2'ーテトラヒドロキシー4'ーメチルベンゾフェ ノン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸 エステル、2,3,4,4'ーテトラヒドロキシー3'ー メトキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジ ドー4ースルホン酸エステル、2,3,4,4'ーテトラヒドロキシー3'ーメトキシベンゾフェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステルなどの、テトラヒドロキシベンゾフェノンと1,2ーナフトキノンジアジドスルホン酸とのエステル化物;

【0032】2,3,4,2',6'ーペンタヒドロキシベンゾフェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、2,3,4,2',6'ーペンタヒドロキシベンゾフェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー10 5ースルホン酸エステル、3,4,5,2',4'ーペンタヒドロキシベンゾフェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、3,4,5,2',4'ーペンタヒドロキシベンゾフェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステルなどの、ペンタヒドロキシベンゾフェノンと1,2ーナフトキノンジアジドスルホン酸とのエステル化物;

【0033】2,4,6,3',4',5'-ヘキサヒドロキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジドー4-スルホン酸エステル、2,4,6,3',4',5'-ヘキサヒドロキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、3,4,5,3',4'5'-4-スルホン酸エステル、3,4,5,3',4'5'-4-スルホン酸エステル、3,4,5,3',4'5'-5'-4-スルホン酸エステル、3,4,5,3',4',5'-ヘキサヒドロキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステルなどの、ヘキサヒドロキシベンゾフェノンと1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸とのエステル化物;

【0034】ビス(2.4ージヒドロキシフェニル)メ 30 タン-1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸 エステル、ビス (2,4-ジヒドロキシフェニル) メタ ンー1.2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エ ステルなどの、ビスジヒドロキシフェニルメタンと1, 2-ナフトキノンジアジドスルホン酸とのエステル化 物;ビス (p-ヒドロキシフェニル) メタンー1,2-ナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、ビス (p-ヒドロキシフェニル) メタン-1,2-ナフトキ ノンジアジドー5ースルホン酸エステルなどの、ビスヒ ドロキシフェニルメタンと1,2-ナフトキノンジアジ 40 ドスルホン酸とのエステル化物; トリ (p-ヒドロキシ フェニル) メタンー1,2ーナフトキノンジアジドー4 -スルホン酸エステル、トリ (p-ヒドロキシフェニ ル) メタンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ースル ホン酸エステルなどの、トリヒドロキシフェニルメタン と1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸とのエステ ル化物;

【0035】1,1,1-トリ(pーヒドロキシフェニル)エタン-1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、1,1,1-トリ(pーヒドロキシフェ50 ニル)エタン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-ス

ルホン酸エステルなどの、トリヒドロキシフェニルエタンと1,2ーナフトキノンジアジドスルホン酸とのエステル化物;ビス(2,3,4ートリヒドロキシフェニル)メタンー1,2ーナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、ビス(2,3,4ートリヒドロキシフェニル)メタンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステルなどの、ビストリヒドロキシフェニルメタンと1,2ーナフトキノンジアジドスルホン酸とのエステル化物;

【0036】2,2ービス(2,3,4ートリヒドロキシフェニル)プロパンー1,2ーナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、2,2ービス(2,3,4ートリヒドロキシフェニル)プロパンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステルなどの、ビストリヒドロキシフェニルプロパンと1,2ーナフトキノンジアジドスルホン酸とのエステル化物;1,1,3ートリス(2,5ージメチルー4ーヒドロキシフェニル)ー3ーフェニルプロパンー1,2ーナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、1,1,3ートリス(2,5ージメチルー4ーヒドロキシフェニル)ー3ーフェニルプロパンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステルなどの、トリス(ジメチルヒドロキシフェニル)フェニルプロパンと1,2ーナフトキノンジアジドスルホン酸とのエステル化物;

[0037]4,4'-[1-[4-[1-[4-t]]ロキシフェニル] -1-メチルエチル] フェニル] エチ リデン] ビスフェノールー1,2-ナフトキノンジアジ ドー4ースルホン酸エステル、4,4'ー[1-[4-[1-[4-ヒドロキシフェニル] -1-メチルエチ ル] フェニル] エチリデン] ビスフェノールー1,2-ナフトキノンジアジドー5-スルホン酸エステルなど の、ヒドロキシフェニルメチルエチルフェニルエチリデ ンビスフェノールと1.2-ナフトキノンジアジドスル ホン酸とのエステル化物;ビス(2,5-ジメチルー4 ーヒドロキシフェニル) -2-ヒドロキシフェニルメタ ン-1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エ ステル、ビス(2,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェ ニル) -2-ヒドロキシフェニルメタン-1,2-ナフ トキノンジアジドー5ースルホン酸エステルなどの、ビ ス (ジメチルヒドロキシフェニル) ヒドロキシフェニル 40 メタンと1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸との エステル化物; 3, 3, 3', 3'ーテトラメチルー1, 1'ースピロインデンー5,6,7,5',6',7'ーへ キサノールー1,2ーナフトキノンジアジドー4ースル ホン酸エステル、3,3,3',3'-テトラメチル-1. 1'ースピロインデンー5,6,7,5',6',7'ーへ キサノールー1,2-ナフトキノンジアジドー5-スル ホン酸エステルなどの、テトラメチルスピロインデンへ キサノールと1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸 とのエステル化物; 2, 2, 4-トリメチルー7, 2',

4'ートリヒドロキシフラバンー1,2ーナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、2,2,4ートリメチルー7,2',4'ートリヒドロキシフラバンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステルなどの、トリメチルトリヒドロキシフラバンと1,2ーナフトキノンジアジドスルホン酸とのエステル化物が挙げられる。

12

【0038】これらのうち、2,3,4ートリヒドロキシ ベンゾフェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー4ー スルホン酸エステル、2,3,4-トリヒドロキシベンゾ フェノン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホ ン酸エステル、2,3,4,4'ーテトラヒドロキシベン ゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジド-4-スル ホン酸エステル、2,3,4,4'ーテトラヒドロキシベ ンゾフェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ース ルホン酸エステル、3,4,5,2',4'ーペンタヒドロ キシベンゾフェノンー1,2-ナフトキノンジアジドー 4-スルホン酸エステル、1,1,3-トリス(2,5-ジメチルー4ーヒドロキシフェニル) -3-フェニルプ ロパン-1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン 酸エステル、1,1,3-トリス(2,5-ジメチル-4 -ヒドロキシフェニル) -3-フェニルプロパン-1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、 4,4'-[1-[4-[1-[4-ヒドロキシフェニ ル] -1-メチルエチル] フェニル] エチリデン] ビス フェノールー1,2ーナフトキノンジアジドー4ースル ホン酸エステル、4,4'-[1-[4-[1-[4-ヒドロキシフェニル] -1-メチルエチル] フェニル] エチリデン] ビスフェノールー1,2-ナフトキノンジ 30 アジドー5-スルホン酸エステル、2,2,4-トリメチ ルー7,2',4'ートリヒドロキシフラバンー1,2-ナフトキノンジアジドー4-スルホン酸エステル、2, 2,4-トリメチルー7,2',4'-トリヒドロキシフ ラバン-1,2- ナフトキノンジアジド-5-スルホ ン酸エステル、1,1,1-トリ (p-ヒドロキシフェニ ル) エタンー1,2ーナフトキノンジアジドー4ースル ホン酸エステル、1,1,1-トリ (p-ヒドロキシフェ ニル) エタンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ース ルホン酸エステルなどが好ましく用いられる。これらの 1,2-キノンジアジド化合物は、単独であるいは2種 以上組み合わせて用いることができる。

【0039】上記のような1,2ーキノンジアジドスルホン酸エステル類は、例えば1,2ーキノンジアジドスルホン酸のハロゲン化物を、塩基触媒の存在下で、対応するヒドロキシ化合物でエステル化させることにより得られる。このようなエステル化反応においては、ヒドロキシ化合物の全水酸基に対して、1,2ーキノンジアジドスルホン酸のハロゲン化物を通常10~120モル%用いることが望ましい。これら1,2ーキノンジアジド50 化合物[B]は、重合体[A]100重量部に対して好

ましくは $5\sim100$ 重量部、より好ましくは $10\sim50$ 重量部含んでいることが望ましい。

【0040】感放射線性樹脂組成物中の1,2-キノンジアジド化合物の量が、重合体 [A] 100重量部に対して5重量部未満であると、該組成物から形成される塗膜は放射線照射部と放射線未照射部との溶解度差が小さくなって現像によるパターニングが困難になることがあり、一方100重量部を超えると、短時間の放射線照射では1,2-キノンジアジド化合物が充分に分解されず、感度が低下してしまうことがある。

[C] 樹脂 [A] と反応して樹脂 [A] 間に架橋を形成 しうる官能基を有する架橋剤

樹脂 [A] と反応して樹脂 [A] 間に架橋を形成しうる 官能基を有する架橋剤としては、下記式 (2) で表わさ れるメラミン類 (以下、「メラミン類」という。)、下 記式 (3) で表させるグリコールウリル類および分子内 に少なくとも 2 個のエポキシ基を有するラジカル重合性 を有さない化合物を好ましいものとして挙げられる。

[0041]

【0042】 [式中、6個のRは、同一または異なり、アルキル基、好ましくは炭素原子数1~4のアルキル基である]で示されるN,N,N',N',N'',N''-(ヘキサアルコキシメチル) メラミンなどのアルコキシメチル化メラミン。

[0043]

【化3】

【0044】 [式中、4個のRは、同一または異なり、式(2)の定義と同じである]で示されるN,N',N',N',-(テトラアルコキシメチル)グリコールウリルなどのアルコキシメチル化グリコールウリル。メラミン類としては、例えば、ヘキサメチロールメラミン、ヘキサブチロールメラミン、部分メチロール化メンラミンおよびそのアルコキシアルキル化メラミン、テトラメチロールベンゾグアナミン、部分メチロール化ベンゾグアナミンおよびそのアルキル化体などを挙げることができる。これらのうちアルコキシアルキル化メラミンが好ましい。

【0045】これらのメラミン類およびグリコールウリ

ルの使用量は、アルカリ可溶性環状ポリオレフィン系樹脂[A]100重量部に対して、1~100重量部、好ましくは5~50重量部である。添加量が1重量部未満のときは系の架橋が不十分で、パターニングが困難となり易くなる。また、100重量部を超えると組成全体のアルカリ溶解性が高くなりすぎるため、現像後の残膜率が低下するという問題が起こり易くなる。

【0046】分子内に少なくとも2個のエポキシ基を有 するラジカル重合性を有さない化合物としては、例えば エピコート1001、同1002、同1003、同10 04、同1007、同1009、同1010、同828 (商品名;油化シェルエポキシ(株)製)などのビスフ エノールA型エポキシ樹脂;エピコート807(商品 名;油化シェルエポキシ(株)製)などのビスフェノー ルF型エポキシ樹脂;エピコート152、同154(商 品名;油化シェルエポキシ(株)製)、EPPN20 1、同202 (商品名;日本化薬(株)製)などのフェ ノールノボラック型エポキシ樹脂; EOCN102、同 1035、同1045、1020、1025、1027 (商品名;日本化薬(株)製)、エピコート180S7 5 (商品名;油化シェルエポキシ (株) 製) などのクレ ゾールノボラック型エポキシ樹脂;エピコート1032 H60、同XY-4000 (商品名;油化シェルエポキ シ (株) 製) などのポリフェノール型エポキシ樹脂、C Y-175、同177、同179、アラルダイトCY-182、同192、184 (商品名; チバーガイギー (株) 製)、ERL-4234、4299、4221、 4206 (商品名; U.C.C社製)、ショーダイン50 9 (商品名;昭和電工(株)製)、エピクロン200、 同400 (商品名;大日本インキ(株)製)、エピコー ト871、同872(商品名;油化シェルエポキシ (株) 製)、ED-5661、同5662 (商品名:セ ラニーズコーティング (株) 製) などの環状脂肪族エポ キシ樹脂;エポライト100MF(共栄社油脂化学工業 (株) 製)、エピオールTMP (日本油脂(株)製)な どの脂肪族ポリグリシジルエーテルなどが挙げられる。 【0047】これらのラジカル重合性を有さない化合物 は、アルカリ可溶性環状ポリオレフィン系樹脂 [A] 1 00重量部に対して、好ましくは1から50重量部の量 で用いられる。

【0048】感放射線性樹脂組成物が含有してもよいその他の成分

本発明に係る感放射線性樹脂組成物は、感度をさらに向上させる目的で、1,2ーキノンジアジド化合物に対する増感剤を含んでいてもよい。このような増感剤としては、例えば2Hーピリドー(3,2-b)-1,4-オキサジン-3(4H)-オン類、10Hーピリドー(3,2-b)-1,4-ベングチアジン類、ウラゾール類、ヒダントイン類、バルビツール酸類、グリシン無水物50類、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール類、アロキサン

類、マレイミド類などが好ましく挙げられる。上記増感 剤は、1,2-キノンジアジド化合物 [B] 100重量 部に対して、通常100重量部以下、好ましくは10重 **量部以下の量で必要に応じて用いられる。**

【0049】さらに本発明の感放射線性樹脂組成物は、 ストリエーション (塗布すじあと) の防止、現像性の向 上などの目的で、界面活性剤を配合することもできる。 界面活性剤としては、例えばポリオキシエチレンラウリ ルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、 ポリオキシエチレンオレイルエーテルなどのポリオキシ 10 エチレンアルキルエーテル類;ポリオキシエチレンオク チルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェ ニルエーテルなどのポリオキシエチレンアリールエーテ ル類;ポリオキシエチレンジラウレート、ポリオキシエ チレンジステアレートなどのポリオキシエチレンジアル キルエステル類などのノニオン系界面活性剤;エフトッ プEF301、同303、同352 (新秋田化成 (株) 製)、メガファックF171、同F172、同F173 (大日本インキ化学工業(株)製)、フロラードFC-430、同FC-431 (住友スリーエム (株) 製)、 アサヒガードAG710、サーフロンS-382、同S C-101、同SC-102、同SC-103、同SC -104、同SC-105、同SC-106(旭硝子 (株) 製) などのフッ素系界面活性剤;オルガノシロキ サンポリマーKP341 (信越化学工業 (株) 製)、ポ リフローNo. 57、同95 (共栄社油脂化学工業

(株) 製) などの (メタ) アクリル酸共重合体系界面活 性剤が挙げられる。

【0050】上記界面活性剤は、感放射線性樹脂組成物 の固形分100重量部に対して、2重量部以下、好まし くは1重量部以下の量で必要に応じて用いられる。本発 明の感放射線性樹脂組成物は、耐熱性、耐薬品性を向上 する目的で潜在性酸発生剤を配合することもできる。本 発明で用いられる潜在性酸発生剤は、加熱により酸を発 生するカチオン重合触媒であり、スルホニウム塩、ベン ゾチアゾリウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩な どのオニウム塩が用いられる。中でも、スルホニウム塩 およびベンゾチアゾリウム塩が好ましい。

【0051】上記スルホニウム塩の具体例としては、例 えば4-アセトフェニルジメチルスルホニウム ヘキサ 40 フルオロアンチモネート、4-アセトキシフェニルジメ チルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、ジメ チルー4-(ベンジルオキシカルボニルオキシ)フェニ ルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ジメ チルー4-(ベンゾイルオキシ)フェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ジメチルー4ー (ベ

ンゾイルオキシ) フェニルスルホニウム ヘキサフルオ ロアルセネート、ジメチルー3-クロロー4-アセトキ シフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネー トなどのアルキルスルホニウム塩:ベンジルー4-ヒド

16

ロキシフェニルメチルスルホニウム ヘキサフルオロア ンチモネート、ベンジルー4-ヒドロキシフェニルメチ ルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、4-ア セトキシフェニルベンジルメチルスルホニウム ヘキサ

フルオロアンチモネート、ベンジルー4ーメトキシフェ ニルメチルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネー

ト、ベンジルー2ーメチルー4ーヒドロキシフェニルメ チルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ベ

ンジルー3-クロロー4-ヒドロキシフェニルメチルス ルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、4-メトキ

シベンジルー4ーヒドロキシフェニルメチルスルホニウ

ム ヘキサフルオロホスフェートなどのベンジルスルホ ニウム塩:

【0052】ジベンジルー4ーヒドロキシフェニルスル ホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ジベンジル -4-ヒドロキシフェニルスルホニウム ヘキサフルオ ロホスフェート、4-アセトキシフェニルジベンジルス ルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ジベンジ ルー4-メトキシフェニルスルホニウム ヘキサフルオ ロアンチモネート、ジベンジルー3ークロロー4ーヒド ロキシフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネ ート、ジベンジルー3ーメチルー4ーヒドロキシー5ー tertーブチルフェニルスルホニウム ヘキサフルオ ロアンチモネート、ベンジルー4ーメトキシベンジルー 4-ヒドロキシフェニルスルホニウム ヘキサフルオロ ホスフェートなどのジベンジルスルホニウム塩; p-ク ロロベンジルー4ーヒドロキシフェニルメチルスルホニ ウム ヘキサフルオロアンチモネート、p-ニトロベン ジルー4ーヒドロキシフェニルメチルスルホニウム へ キサフルオロアンチモネート、p-クロロベンジル-4 ーヒドロキシフェニルメチルスルホニウム ヘキサフル オロホスフェート、p-ニトロベンジル-3-メチルー 4-ヒドロキシフェニルメチルスルホニウム ヘキサフ ルオロアンチモネート、3.5-ジクロロベンジルー4 ーヒドロキシフェニルメチルスルホニウム ヘキサフル オロアンチモネート、o-クロロベンジル-3-クロロ -4-ヒドロキシフェニルメチルスルホニウム ヘキサ フルオロアンチモネートなどの置換ベンジルスルホニウ ム塩:下記式(4)~(10)で示されるスルホニウム 塩が挙げられる。

[0053]

【化4】

7

$$CH_{2}$$
 CH_{3}
 C

【0054】上記ベンゾチアゾニウム塩の具体例として は3-ベンジルベンゾチアゾリウムヘキサフルオロアン チモネート、3-ベンジルベンゾチアゾリウム ヘキサ フルオロホスフェート、3-ベンジルベンゾチアゾリウ ム テトラフルオロボレート、3-(p-メトキシベン ジル) ベンゾチアゾリウム ヘキサフルオロアンチモネ ート、3-ベンジル-2-メチルチオベンゾチアゾリウ ム ヘキサフルオロアンチモネート、3-ベンジル-5 ークロロベンゾチアゾリウム ヘキサフルオロアンチモ ネートなどのベンジルベンゾチアゾリウム塩が挙げられ

【0055】これらのうち、4ーアセトキシフェニルジ メチルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、ベ ンジルー4-ヒドロキシフェニルメチルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、4-アセトキシフェニ ルベンジルメチルスルホニウム ヘキサフルオロアンチ モネート、ジベンジルー4-ヒドロキシフェニルスルホ ニウム ヘキサフルオロアンチモネート、4-アセトキ シフェニルベンジルスルホニウム ヘキサフルオロアン ルオロアンチモネートなどが好ましく用いられる。これ らの市販品としては、サンエイドSI-L85、同SI -L110、同SI-L145、同SI-L150、同 SI-L160 (三新化学工業 (株) 製) などが挙げら れる。

 $CF_3SO_3^-$ (10)

【0056】これらの化合物は、単独であるいは2種以 上組み合わせて用いることができる。その他、本発明の 感放射線性樹脂組成物は、基板との密着性を向上させる 目的で、密着助剤を含んでいてもよい。このような密着 助剤としては、官能性シランカップリング剤などが挙げ られる。該官能性シランカップリング剤の具体例として は、トリメトキシシリル安息香酸、γーメタクリロキシ プロピルトリメトキシシラン、ビニルトリアセトキシシ ラン、ビニルトリメトキシシラン、γーイソシアネート プロピルトリエトキシシラン、γーグリシドキシプロピ ルトリメトキシシラン、 β - (3,4-エポキシシクロ ヘキシル) エチルトリメトキシシランなどが挙げられ る。該密着助剤の使用割合は、樹脂 [A] 成分100重 量部に対して、通常、20重量部以下、好ましくは0. チモネート、3-ベンジルベンゾチアソリウムヘキサフ 50 05~10重量部、特に好ましくは1~10重量部であ

る。さらに本発明に係る感放射線性樹脂組成物は、必要 に応じて帯電防止剤、保存安定剤、消泡剤、顔料、染料 などを含んでいてもよい。

【0057】感放射線性樹脂組成物の調製

本発明の感放射線性樹脂組成物は、上記の各成分を均一 に混合することによって容易に調製することができ、通 常、適当な溶媒に溶解されて溶液状態で用いられる。例 えば、樹脂 [A] を溶媒に溶解し、この溶液に1,2-キノンジアジド化合物 [B] および架橋剤 [C] および 必要に応じて他の成分を所定の割合で混合することによ り、溶液状態で感放射線性樹脂組成物を調製することが できる。

【0058】該溶媒としては、例えばメタノール、エタ ノール、プロパノール、ブタノールなどのアルコール 類:テトラヒドロフラン、ジオキサンなどの環状エーテ ル類;メチルセロソルブアセテート、エチルセロソルブ アセテートなどのセロソルブエステル類:エチレングリ コールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエ チルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテ ル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチ レングリコールジメチルエーテル、プロピレングリコー ルモノメチルエーテルなどのグリコールエーテル類:プ ロピレングリコールメチルエーテルアセテート、プロピ レングリコールプロピルエーテルアセテートなどのプロ ピレングリコールアルキルエーテルアセテート類:

【0059】ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香 族炭化水素類;メチルエチルケトン、シクロヘキサノ ン、2-ヘプタノン、4-ヒドロキシー4-メチルー2 ーペンタノンなどのケトン類;2ーヒドロキシプロピオ ン酸エチル、2-ヒドロキシー2-メチルプロピオン酸 30 エチル、2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオン酸エチ ル、エトキシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、2-ヒドロキシー3-メチルブタン酸メチル、3-メトキシ プロピオン酸メチル、3-メトキシプロピオン酸エチ ル、3-エトキシプロピオン酸エチル、3-エトキシプ ロピオン酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチルなどのエス テル類;ジメチルホルムアミド、N-メチル-2-ピロ リドンなどの非プロトン性極性溶媒が挙げられる。N-メチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、 N-メチルホルムアニリド、N-メチルアセトアミド、 N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリド ン、ジメチルスルホキシド、ベンジルエチルエーテル、 ジヘキシルエーテル、アセトニルアセトン、イソホロ ン、カプロン酸、カプリル酸、1-オクタノール、1-ノナノール、ベンジルアルコール、酢酸ベンジル、安息 香酸エチル、シュウ酸ジエチル、マレイン酸ジエチル、 γーブチロラクトン、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、 フェニルセロソルプアセテートなどの溶媒を用いること もできる。

形成のしやすさから、メチルエチルケトン、シクロヘキ サノン、2-ヘプタノン、4-ヒドロキシ-4-メチル -2-ペンタノンなどのケトン類およびエチレングリコ ールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメ チルエーテルなどのグリコールエーテル類が好ましく用 いられる。

【0061】本発明の感放射線性樹脂組成物は、固形分 濃度が好ましくは10~40重量%となるように溶媒に 溶解された溶液として被塗布物に塗布される。また、上 記のように調製された感放射線性樹脂組成物溶液は、孔 径が 0.5 μ m程度のフィルタなどを用いて濾過した 後、使用に供することが好ましい。このように調製され た感放射線性樹脂組成物溶液は、長期間の貯蔵安定性に も優れる。

【0062】感放射線性樹脂組成物の使用法

本発明の感放射性樹脂組成物溶液は、基板表面に塗布さ れ、加熱により溶媒の除去を受けることによって、塗膜 を形成することができる。基板表面への感放射性樹脂組 成物溶液の塗布方法としては、例えばスプレー法、ロー ルコート法、回転塗布法などの各種の方法を採用するこ とができる。次いでこの塗膜は、加熱(プレベーク)さ れる。加熱することによって、溶剤が揮発し、流動性の ない途膜が得られる。加熱条件は、各成分の種類、配合 割合などによっても異なるが、通常60~120℃で1 0~600秒間程度である。

【0063】次に加熱された塗膜に所定パターンのマス クを介して放射線を照射した後、現像液により現像し、 不要な部分を除去する。現像液としては、例えば水酸化 ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸 ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水など の無機アルカリ類;エチルアミン、n-プロピルアミンな どの第一級アミン類:ジエチルアミン、ジーn-プロピ ルアミンなどの第二級アミン類;トリエチルアミン、メ チルジエチルアミン、N-メチルピロリドンなどの第三 級アミン類;ジメチルエタノールアミン、トリエタノー ルアミンなどのアルコールアミン類; テトラメチルアン モニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒド ロキシド、コリンなどの第四級アンモニウム塩;ピロー ル、ピペリジン、1.8-ジアザビシクロ[5.4.0] 40 -7-ウンデセン、1,5-ジアザビシクロ [4.3.

0] -5-ノナンなどの環状アミン類のアルカリ類から なるアルカリ水溶液を用いることができる。また上記ア ルカリ水溶液に、メタノール、エタノールなどの水溶性 有機溶媒、界面活性剤などを適当量添加した水溶液を現 像液として使用することもできる。

【0064】現像時間は、通常30~180秒間であ る。また現像方法は液盛り法、ディッピング法などのい ずれでもよい。現像後、流水洗浄を30~90秒間行 い、圧縮空気や圧縮窒素で風乾させることによって、基 【0060】これらの溶媒のうち、溶解性および塗膜の 50 板上の水分を除去し、パターン状被膜が形成される。そ

の後このパターン状被膜に、高圧水銀灯などによる放射線を全面照射し、パターン状被膜中に残存する1,2ーキノンジアジド化合物を完全に分解させる。続いて、ホットプレート、オーブンなどの加熱装置により、所定温度、例えば150~250℃で、所定時間、例えばホットプレート上なら5~30分間、オーブン中では30~90分間加熱処理をすることによって、パターン状架橋被膜を得ることができる。

[0065]

【実施例】以下、本発明の実施例について説明するが、 本発明はこれらによって何ら制限されるものではない。 実施例中「部」は「重量部」を意味する。

【0066】合成例1

単量体としての下記式(11)

[0067]

【化5】

【0068】で表される8-メチル-8-メトキシカル 20 ボニルテトラシクロ [4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] -3-ドデセン250部、1-ヘキセン180部およびトルエン750部を、窒素置換した反応容器に仕込み、60℃に加熱した。これに、トリエチルアルミニウム(1.5モル/1)のトルエン溶液0.62部、tert-C4H5OH/CH3OH/で変性(tert-C4H9OH/CH3OH/W=0.35/0.3/1;モル比)したWC16溶液(濃度0.05モル/1)3.7部を加え、80℃で3時間加熱攪拌して、開環重合体溶液を得た。この重合反応における重合転化率は90%であり、重合体の重量 30平均分子量は17.000であった。

【0069】得られた重合体溶液4,000部をオートクレーブに入れ、これにRuHCl (CO) [P (C6 H5)3]30.48部を加え、水素ガス圧を100Kg/cm²反応温度165℃の条件で3時間加熱攪拌した。得られた反応溶液を冷却した後、水素ガスを放圧し、水素添加重合体溶液(b)を得た。こうして得られた水素添加重合体を大量のメタノール中に注いで、重合体を凝固させた。こうして得られた水素添加重合体の水素化率は実質上100%であった。得られた水素添加重

合体100部、N-メチルピロリドン100部、プロピレングリコール500部、水酸化カリウム(85%)84.5部を反応器に仕込み190℃で4.5時間加熱撹拌した。得られた反応溶液を大量の水、テトラヒドロフランおよび塩酸の混合溶液に注いで加水分解物を凝固させた。凝固ポリマーを水洗、乾燥して加水分解重合体(A-1)を得た。得られた加水分解重合体の加水分解率は95%であった。

【0070】合成例2

10 単量体として8-メチル-8-メトキシカルボニルテトラシクロ [4.4.0.12,5.17,10] -3ードデセンと5-メチル-5-メトキシカルボニルビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-エンとの混合物 (80/20(モル比)) を用いたこと以外は合成例1と同様にして 開環重合反応、水素添加反応、加水分解を行い加水分解 重合体 (A-2) を得た。

合成例3

単量体として8-メチル-8-メトキシカルボニルテトラシクロ $\begin{bmatrix} 4.4.0.12,5.17,10 \end{bmatrix} -3-$ ドデセン250部、1-ヘキセン180部およびトルエン 750部を、窒素置換した反応容器に仕込み、60 で 単量体として8-メチル-8-メトキシカルボニルテトラシクロ $\begin{bmatrix} 4.4.0.1^2.5.1^{7.10} \end{bmatrix} -3-$ (80/20 (モル比))を用いたこと以外は合成例 1 と同様にして開環重合反応、水素添加反応、加水分解を行い加水分解重合体(100 を得た。

【0071】合成例4

1-ヘキセンを60部とした以外は合成例1と同様にして開環重合反応、水素添加反応、加水分解を行い加水分解重合体(A-4)を得た。

合成例 5

加水分解時間を1.5時間とした以外は合成例1と同様にして開環重合反応、水素添加反応、加水分解を行い加水分解重合体 (A-5)を得た。合成例1から5における重合転化率、重量平均分子量、加水分解率を表1に示した。合成例1から5における水素添加重合体の水素化率は実質上100%であった。重量平均分子量は、GPC(ゲルパーミエイションクロマトグラフィ)(東ソー(株)製HLC-8020)を用いて測定したポリスチレン換算分子量である。

[0072]

【表 1 】

加水分解率(%) 重合転化率(%) 重量平均分子量 合成例1 90 17,000 9.5 97 合成例2 8 9 13.000 93 合成例3 21,000 9.5 95 合成例4 94 41,000 90 17.000 75 合成例5

【0073】感放射線性樹脂組成物の調製 実施例1

合成例1で得られた加水分解重合体(A-1)100重 量部と、溶剤としてシクロヘキサノン550部、1,2 ーキノンジアジド化合物として1,1,3-トリス(2, 5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニルー3-フェニ ル) プロパン(1モル)と1,2-ナフトキノンジアジ ドー5ースルホン酸クロリド(1.9モル)との縮合物 ([B-1]) 20 重量部および架橋剤としてCYME 20 す。 L300 25部と接着助剤としてyーグリシドキシプ ロピルトリメトキシシラン5部と界面活性剤としてメガ ファックF172 (大日本インキ化学工業 (株) 製) 0.05部を混合し溶解させた後、孔径0.45μmのミ リポアフィルタで濾過して感放射線性樹脂組成物溶液を 調製した。

【0074】 [塗膜の形成] シリコン基板上にスピンナ ーを用いて、得られた上記樹脂組成物溶液を塗布した 後、90℃て120秒間ホットプレート上でプリベーク して膜厚3.0μmの塗膜を形成した。

[放射線照射処理、および現像処理] 得られた塗膜に所 定のパターンのマスクを介して、365nmにおける光 強度が5mW/cm2である紫外線を空気中で40秒間 照射した。次いで、テトラメチルアンモニウムヒドロキ シド0.3重量%水溶液により25℃で60秒間現像処 理を行った後、超純水で1分間リンス処理し、ポジ型の パターンを形成させた。その後、全面に365nmにお ける光強度が5mW/cm²である紫外線を空気中で6 0秒間照射した。

【0075】 [ポストベーク] このパターンが形成され 40 たシリコン基板をホットプレート上で200℃で30分 間加熱することにより、パターンのポストベークを行 い、パターン状薄膜を形成したシリコン基板を得た。 誘電率の測定

室温、10KHzの条件で測定した。結果を表1に示

[耐熱寸法安定性の評価] パターン状薄膜を形成したシ リコン基板を220℃のオーブンを用いて60分間加熱 した後、パターン状薄膜の膜厚変化を測定した。加熱後

0~95%の範囲にある場合を△、90%未満の場合を ×とした。結果を表2に示す。

【0076】 [平坦性の評価] シリコン基板の代わり に、1.0 μmの段差を有するシリコン酸化膜基板を用 いたこと以外は、前記と同様にしてパターン状薄膜を形 成し、接触式の膜厚測定器を用いて、パターン状薄膜の 段差を測定し、段差の最大値が5%未満である場合を○ とし、5%以上である場合を×とした。結果を表2に示

[透明性の評価] シリコン基板の代わりにガラス基板 「コーニング7059 (コーニング社製)」を用いた以 外は上記と同様にしてパターン状薄膜を形成したガラス 基板を得た。次いで、得られたガラス基板の透過率を分 光光度計「150-20型ダブルビーム(日立製作所 製)」を用いて400~800nmの波長で測定した。 このとき最低透過率が90%を超える場合を〇、90% 未満である場合を×とした。結果を表2に示す。

【0077】 [耐熱変色性の評価] パターン状薄膜を形 成したガラス基板を220℃のオーブンで60分間加熱 した後、このガラス基板の透過率を分光光度計「150 -20型ダブルビーム」を用いて400~800nmの 波長で測定し、加熱処理後における透過率の変化を求め た。透過率の変化率が5%未満の場合を〇、5~10% の範囲にある場合を△、10%を超える場合を×とし た。結果を表2に示す。

[耐溶剤性の評価] パターン状薄膜を形成したガラス基 板を70℃中のジメチルスルフォキシド中に15分間浸 漬し、膜厚変化を測定した。10%以下の膜厚変化を ○、10%を越える場合を△、膨潤が大きく、基板から 剥がれてしまう状態を×とした。結果を表2に示す。 【0078】実施例2

実施例1において、加水分解重合体を(A-2)に代え た以外は、実施例1と同様にして感放射線性樹脂組成物 溶液を調製した。途膜及び加熱硬化膜の形成ならびに評 価を行った結果を表2に示す。

実施例3

実施例1において、加水分解重合体を(A-3)に代え た以外は、実施例1と同様にして感放射線性樹脂組成物 の膜厚が、加熱前の膜厚の95%を超える場合を○、9 50 溶液を調製した。塗膜及び加熱硬化膜の形成ならびに評

価を行った結果を表2に示す。

【0079】実施例4

実施例1において、加水分解重合体を(A-4)に代えた以外は、実施例1と同様にして感放射線性樹脂組成物溶液を調製した。塗膜及び加熱硬化膜の形成ならびに評価を行った結果を表2に示す。

実施例5

実施例1において、加水分解重合体を(A-5)に代えた以外は、実施例1と同様にして感放射線性樹脂組成物溶液を調製した。塗膜及び加熱硬化膜の形成ならびに評 10 価を行った結果を表2に示す。

【0080】実施例6

実施例 1 において、 1, 2-キノンジアジド化合物を 4, 4'-[1-[4-[1-[4-ヒドロキシフェニル]-1-メチルエチル] フェニル] エチリデン] ビスフェノール (1 モル) と <math>1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸クロリド (2 モル) との縮合物に代えた以外は、実施例 <math>1 と同様にして感放射線性樹脂組成物溶液を調製した。塗膜及び加熱硬化膜の形成ならびに評価を行った結果を表 2 に示す。

実施例7

*実施例1において、1,2ーキノンジアジド化合物を2,3,4ートリヒドロキシベンゾフェノン(1モル)と1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸クロリド(2.6モル)との縮合物に代えた以外は、実施例1と同様にして感放射線性樹脂組成物溶液を調製した。塗膜及び加熱硬化膜の形成ならびに評価を行った結果を表2に示す。

26

【0081】実施例8

実施例1において、架橋剤をエピコート828に代えた 以外は、実施例1と同様にして感放射線性樹脂組成物溶 液を調製した。塗膜及び加熱硬化膜の形成ならびに評価 を行った結果を表2に示す。

実施例9

実施例1において、さらにサンエイドSI-L150 (三新化学工業(株)製) (3部)を加え、実施例1と 同様にして感放射線性樹脂組成物溶液を調製した。塗膜 及び加熱硬化膜の形成ならびに評価を行った結果を表2 に示す。

【0082】 【表2】

.

20

	誘電率	耐熱寸法 安定性	平坦性	透明性	耐熱 変色性	耐溶剤性
実施例1	2.78	0	0	0	0	0
実施例2	2.85	0	0	0	0	0
実施例3	2.72	0	0	0	0	0
実施例4	2.80	0	0	0	0	0
実施例5	2.80	0	0	0	0	0
実施例6	2.77	0	0	0	0	0
実施例7	2.78	0	0	0	0	0
実施例名	2 9 1	0	0	0	0	0

[0083]

【発明の効果】本発明の感放射線性樹脂組成物によれば、絶縁性、平坦性、耐熱性、透明性、耐薬品性などの

実施例9

2.81

O

諸性能に優れるとともに、低誘電性に優れたパターン状 40 薄膜を容易に形成することができる。

フロントページの続き

(51) Int. CI. 6

識別記号

FI

-14-

HO1L 21/027

H O 1 L 21/30

502R

21/768

21/90

S

(72) 発明者 遠藤 昌之 東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合 成ゴム株式会社内 【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】 平成16年10月7日(2004.10.7)

【公開番号】特開平10-307388

【公開日】平成10年11月17日(1998.11.17)

【出願番号】特願平9-115846

【国際特許分類第7版】

G 0 3 F 7/022

C 0 8 F 2/46

G 0 3 F 7/004

G O 3 F 7/033

G 0 3 F 7/039

H O 1 L 21/027

H O 1 L 21/768

[FI]

G O 3 F 7/022

C 0 8 F 2/46

G 0 3 F 7/004 5 0 3 Z

G 0 3 F 7/033

G 0 3 F 7/039 5 0 1

H O 1 L 21/30 5 O 2 R

H O 1 L 21/90

【手続補正書】

【提出日】平成15年9月25日(2003.9.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】感放射線性樹脂組成物、層間絶縁膜およびその製造法

S

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

[A] アルカリ可溶性環状ポリオレフィン系樹脂、

[B] 1,2-キノンジアジド化合物 および

[C] 樹脂 [A] と反応して樹脂 [A] 間に架橋を形成しうる官能基を有する架橋剤を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物。

【請求項2】

層間絶縁膜形成用である請求項1に記載の感放射線性樹脂組成物。

【請求項3】

- (1)請求項1に記載の感放射線性樹脂組成物の塗膜を基板上に形成する工程、
- (2) 工程(1) で形成された塗膜をプレベークする工程、
- (3)工程(2)でプレベークされた塗膜に所定パターンを介して放射線を照射する工程

- (4) 工程 (<u>3) で得られた塗膜をアルカリ水溶液で現像する工程、</u>
- <u>(5)工程(4)で得られたパターン状被膜の全面に放射線を照射する工程 および</u>
- (6) 工程 (5) で得られたパターン状被膜を加熱する工程、

からなることを特徴とする層間絶縁膜の製造法。

【請求項4】

請求項3の方法により製造された層間絶縁膜。

【手続補正3】

【補正対象曹類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 0 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、感放射線性樹脂組成物<u>層間絶縁膜およびその製造法</u>に関する。さらに詳しくは、電子部品に用いられる保護膜などを形成するための材料<u>として</u>、または層間絶縁膜、特に、液晶表示素子、集積回路素子、固体撮像素子などの層間絶縁膜を形成するための材料として好適な低誘電性の感放射線性樹脂組成物<u>その組成物から層間絶縁膜を製造する方法および製造された層間絶縁膜</u>に関する。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 0 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、以上のような事情に基づいてなされたものであって、その目的は、絶縁性、平坦性、耐熱性、透明性、耐薬品性などの諸性能に優れるとともに、低誘電性に優れたパターン状薄膜を容易に形成することができる感放射線性樹脂組成物を提供することにある。本発明の他の目的は、感光性、感光後のアルカリ水溶液による現像性、得られる膜の耐熱性、耐溶剤性および透明性を良好に維持しつつ、得られる膜の低誘電化を図るという困難な問題を克服して、上記の如き本発明の感放射線性樹脂組成物を提供することにある。本発明のさらに他の目的は、本発明の上記感放射線性樹脂組成物から上記の如き優れた諸性能を備えた層間絶縁膜を製造する方法を提供することにある。

本発明のさらに他の目的は、上記層間絶縁膜を提供することにある。

本発明のさらに他の目的および利点は、以下の説明から明らかになろう。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 0 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0005]

【発明を解決するための手段】

本発明によれば、本発明の上記目的および利点は、第1に、

- [A] アルカリ可溶性環状ポリオレフィン系樹脂、
- [B] 1,2-キノンジアジド化合物および
- [C] 樹脂 [A] と反応して樹脂 [A] 間に架橋を形成しうる官能基を有する架橋剤を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物によって達成される。

本発明によれば、本発明の上記目的および利点は、第2に、

- (1)本発明の上記感放射線性樹脂組成物の塗膜を基板上に形成する工程、
- (2)工程(1)で形成された塗膜をプレベークする工程、

(3) 工程(2) でプレベークされた塗膜に所定パターンを介して放射線を照射する工程

.

- (4)工程(3)で得られた塗膜をアルカリ水溶液で現像する工程、
- <u>(5)工程 (4) で得られたパターン状被膜の全面に放射線を照射する工程 および</u>
- <u>(6) 工程 (5) で得られたパターン状被膜を加熱する工程、</u>
- <u>からなることを特徴とする層間絶縁膜の製造法によって達成される。</u>
- <u>また、本発明によれば、本発明の上記目的および利点は、第3に、本発明の上記製造法に</u>より形成された層間絶縁膜によって達成される。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 7 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0074]

[塗膜の形成]

シリコン基板上にスピンナーを用いて、得られた上記樹脂組成物溶液を塗布した後、90 ℃で1 2 0 秒間ホットプレート上でプ<u>レ</u>ベークして膜厚 3 . 0 μ m の塗膜を形成した。

[放射線照射処理、および現像処理]

得られた塗膜に所定のパターンのマスクを介して、 365nmにおける光強度が $5mW/cm^2$ である紫外線を空気中で 40 秒間照射した。

次いで、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド 0.3 重量%水溶液により 25 ℃で 60 秒間現像処理を行った後、超純水で 1 分間リンス処理し、ポジ型のパターンを形成させた。その後、全面に 365 n m における光強度が 5 m W / <math>c m 2 である紫外線を空気中で 6 0 秒間照射した。